

RFMD 新闻发布



联络方式:

RF Micro Devices Inc.
Brian K. Cockman, 公关专员
7628 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409-9421, USA
电话: +1 (336) 678-8945
bcockman@rfmd.com

RFMD 推出 48V 高功率 GaN 晶体管系列

新型 GaN 产品将功率、带宽及效率进行了完美结合

夏威夷、檀香山, 2007 年 6 月 14 日 - (IEEE MTT-S) - 日前, 设计与制造面向可推动移动通信的应用的高性能射频系统与解决方案的全球领先者 RF Micro Devices, Inc. (Nasdaq 股市代号: RFMD) 宣布推出 RF393X 系列 48V 氮化镓 (GaN) 功率晶体管。RF393X 产品系列可提供 10W~120W 的功率性能以及超宽的可调带宽 — 展示了 RFMD GaN 技术提供的高功率与带宽的出色组合, 该技术远胜于 GaAs 及硅 LDMOS 同类竞争技术。

RFMD 的 RF393X 产品系列由五个 48V GaN 非匹配功率晶体管组成, 在 2.1GHz 时每个均可提供 14dB~16dB 的增益以及超过 65% 的高峰值漏极效率。RFMD GaN 功率晶体管的出色性能使它们非常适用于宽带、高效功率放大器应用, 例如广播电视、无线基础设施、高功率雷达、航天及航空电子。RFMD 估计, GaN 高功率半导体的总现有市场约为 10 亿美元, 其中 GaN 非匹配功率晶体管市场约为 1.5 亿美元。该公司目前与多个市场中的顶级客户进行配合, 预计将于 2007 年下半年开始进行生产。

RFMD 总裁兼首席执行官 Bob Bruggeworth 指出: “RFMD 将自身定位于在这个 10 亿美元的高功率半导体市场中获取大量市场份额。我们在无线半导体行业中建立了无与伦比的客户关系, 并且在复合半导体制造方面堪称业界领先者, 我们是全球领先的蜂窝功率放大器制造商。当我们扩展我们的 GaN 产品系列以便在多个高速增长的市场中推动新的增长商机时, 我们将充分利用这些核心能力。”

RFMD 正在开发三种高电压 GaN 产品系列。除 GaN 功率晶体管外，该公司还正在开发高功率 GaN RF 集成电路 (RFIC) 及高功率 GaN 匹配晶体管。高功率 GaN RFIC 为完全匹配的高功率放大器，可在带宽的多个倍频程中提供高效率，并且适用于军用通信、公共移动无线电及软件定义无线电 (SDR) 等应用。高功率 GaN 匹配晶体管包括可改进阻抗及效率的内部匹配元件，并且适用于高功率雷达以及面向 WCDMA 及 WiMAX 的基础设施等应用。

关于 RFMD: RFMD 堪称设计与制造面向可推动移动通信的应用的高性能射频系统与解决方案的全球领先者。RFMD 的功率放大器、发送模块、蜂窝收发器及片上系统 (SOC) 解决方案可实现全球移动性，提供更高的连接能力，以及支持当代及下一代移动手机、蜂窝基站、无线局域网 (WLAN)、无线个人区域网络 (WPAN) 及全球定位系统 (GPS) 中的高级功能。RFMD 因其多样化的一流半导体技术以及广泛的 RF 系统专业技能而著称，在使全球领先移动终端制造商能够提供可满足当前及未来市场需求的先进无线功能方面，RFMD 为首选供应商。

RFMD 总部位于北卡罗来纳、格林斯伯勒，是一家在全球拥有工程、设计、销售及服务机构的 ISO 9001 及 ISO 14001 认证制造商。RFMD 在纳斯达克全球市场上市交易，交易代码为 RFMD。有关更多信息，请访问 RFMD 网站：www.rfmd.com。

本新闻稿包含符合《1995 年美国私人证券诉讼改革法》“安全港”条例的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括，但不限于，有关我们计划、目标、陈述及论点的声明，并且并非历史事实，这些声明一般可通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“能够”、“期望”、“计划”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”及类似措辞的使用加以辨别，尽管有些前瞻性声明是通过不同方式加以表述的。您应了解，本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断及期望，但我们的实际结果、活动和业绩可能与前瞻性声明所表达或暗示的有重大差异。除联邦证券法所要求的之外，我们不打算更新任何这些前瞻性声明，也不计划公开宣布对这些前瞻性声明的任何修订结果。RF Micro Devices 的业务受多种风险和不确定性因素的影响，包括季度运营结果的易变性；无线市场的成长与发展速率；与以下机构的运营相关的风险：我们的晶圆制造机构、分子束外延机构、我们的装配机构，以及我们的测试、带盘机构；吸引和保留熟练员工及培养领导者的能力；生产良率的易变性；采用新技术以降低成本、提高毛利率的能力；将新产品推向市场的能力；快速调整产能以适应产品需求变化的能力；对有限客户的依赖；对第三方的依赖。在由美国证券交易委员会归档的 RF Micro Devices 10-K 报表的最新年度报告中更详细讨论的这些以及其它风险和不确定性因素，可能导致实际结果和发展与此处任何一个前瞻性声明中明示或暗示的意义存在本质性偏差。

RF MICRO DEVICES® 和 RFMD® 为 RFMD, LLC. 的商标。所有其它商品名称、商标及注册商标归其各自所有者所有。

###